WIPO PCT

許 厅 \mathbf{H} **OFFICE** JAPAN **PATENT**

02.08.2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されて いる事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 8月 1日

号 出 願 Application Number:

人

特願2003-285254

[ST. 10/C]:

[JP2003-285254]

出 願 Applicant(s): 松下電器産業株式会社

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 4月14日



BEST AVAILABLE COPY



特許願 【書類名】 【整理番号】 2925040145 平成15年 8月 1日 【提出日】 特許庁長官 殿 【あて先】 H01L 27/14 【国際特許分類】 【発明者】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 【住所又は居所】 山口 琢己 【氏名】 【発明者】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 【住所又は居所】 春日 繁孝 【氏名】 【発明者】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 【住所又は居所】 【氏名】 村田 隆彦 【発明者】 大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内 【住所又は居所】 折田 賢児 【氏名】 【特許出願人】 【識別番号】 000005821 【氏名又は名称】 松下電器産業株式会社 【代理人】 【識別番号】 100090446 【弁理士】 【氏名又は名称】 中島 司朗 【手数料の表示】 014823 【予納台帳番号】 21,000円 【納付金額】

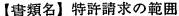
【物件名】 特許請求の範囲 1

 【物件名】
 明細書 1

 【物件名】
 図面 1

 【物件名】
 要約書 1

 【包括委任状番号】
 9003742



【請求項1】 ·

半導体基板内に2次元状に配列した複数の受光素子と、

該受光素子に入射する光の波長を選択する波長選択層と、

入射する光を遮断する遮光膜と該遮光膜が複数の該受光素子のそれぞれに対向して開口 した開口部と

からなる遮光層と

を有する固体撮像装置であって、

該波長選択層を該半導体基板と該遮光層との間に形成する

ことを特徴とする固体撮像装置。

【請求項2】

前記半導体基板において前記遮光膜の開口部上に

複数の前記受光素子のそれぞれに対応して複数のマイクロレンズを

形成することを特徴とする請求項1記載の固体撮像装置。

【請求項3】

前記波長選択層がカラーフィルターから成ることを特徴とする請求項2記載の固体撮像装置。

【請求項4】

前記波長選択層が無機材料から成ることを特徴とする請求項2記載の固体撮像装置。

【請求項5】

前記波長選択層が多層膜から成ることを特徴とする請求項2記載の固体撮像装置。

【請求項6】

前記波長選択層がフォトニック結晶から成ることを特徴とする請求項2記載の固体撮像装置。

【請求項7】

半導体基板内に2次元状に配列した複数の受光素子と、

該受光素子に入射する光の波長を選択する波長選択層と、

を有する固体撮像装置であって、

該波長選択層がフォトニック結晶から成る

ことを特徴とする固体撮像装置。

【請求項8】

請求項1~7のいずれか1項に記載の固体撮像装置を備えたカメラ。

【書類名】明細書

【発明の名称】固体撮像装置およびカメラ

【技術分野】

[0001]

本発明はデジタルカメラ等に使用される固体撮像装置に関する。

【背景技術】

[0002]

従来の固体撮像装置における平面図を図5に示す。半導体基板1において入射する光を受ける受光素子2が2次元状に配列されている。撮像の単位は画素と呼ばれるが、一つの画素はひとつの受光素子からなる。図6は従来の固体撮像装置における画素の断面を示している。ここでは3つの隣り合う画素の断面を示している。

入射する光14は受光素子2に達する前に、通常、画素ごとに配置されたマイクロレンズ13により当該画素に集められ、これも画素ごとに配置されたカラーフィルター12によって特定の色だけがろ過され、当該画素の受光素子2に到達するようになっている。そして隣りの画素の受光素子に到達しにくいように、受光素子間の上に遮光膜11が形成している。受光素子2は受けとった色の光の輝度を、光電変換により電荷に変えて蓄える。図示はしていないがその電荷が当該画素の色の輝度情報として、水平および垂直のレジスタなどの転送部によって転送され、撮像データとして出力される。なおこれと同様な構成例が特開平05-6986号に開示されている。

【特許文献1】特開平05-6986号

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0003]

画素にはさまざまな方向から光が入射する。画素に垂直に入射する光はその画素のカラーフィルターを通過してその画素の受光素子に入射することができる。ところが斜め光(斜めに入射した光)は隣の画素のカラーフィルターの一部を通過した後に受光素子に入射する場合があり、隣の画素の色との混色(隣と同じ色の時は混信)が発生してしまうこととなる。本発明の課題は、この混色をできるだけ防止することにある。

【課題を解決するための手段】

[0004]

上記課題を解決するために本発明の固体撮像装置は、

半導体基板内に2次元状に配列した複数の受光素子と、

該受光素子に入射する光の波長を選択する波長選択層と、

入射する光を遮断する遮光膜と該遮光膜が複数の該受光素子のそれぞれに対向して開口した開口部と

からなる遮光層とを有する固体撮像装置であって、

該波長選択層を該半導体基板と該遮光層との間に形成することを特徴とする。

[0005]

また、半導体基板において遮光膜間の開口部の上に複数の受光素子のそれぞれに対応して複数のマイクロレンズを形成することを特徴とする。

また、波長選択層がカラーフィルターから成ることを特徴とする。

また、波長選択層が無機材料から成ることを特徴とする。

また、波長選択層が多層膜から成ることを特徴とする。

[0006]

また、波長選択層がフォトニック結晶から成ることを特徴とする。

また、半導体基板内に2次元状に配列した複数の受光素子と、該受光素子に入射する光 の波長を選択する波長選択層と、を有する固体撮像装置であって、波長選択層がフォトニック結晶から成る

ことを特徴とする。

[0007]

さらに、上記の特徴を備えた固体撮像装置を用いたカメラを特徴とする。

【発明の効果】

[0008]

本発明の固体撮像装置は、波長選択層の上に遮光膜を形成しているので、斜め度合いが小さな斜め光による隣の画素への侵入が抑制される。

また、前記半導体基板において遮光膜の開口部の上にマイクロレンズを形成しているので。隣の画素へ侵入しやすい斜め度合いの大きな斜め光が削減され、また画素への集光率を高められる。

[0009]

また、前記波長選択層がカラーフィルターから成るので、遮光膜を通過した光は所望のカラーフィルターのみを通過して受光素子に入射するようになるため混色を防止することができる。

また、前記波長選択層が無機材料で構成するので、半導体製造工程の途中の工程で形成することができ、したがって製造を容易にすることができる。

[0010]

また、前記波長選択層が多層膜から成るので、波長を選択する層を薄膜化することができ、遮光膜と受光素子の距離を近くすることができるため、混色を防ぐと同時に集光率を向上することができる。

また、前記波長選択層がフォトニック結晶から構成する、あるいは半導体基板内に 2 次元状に配列した複数の受光素子と、該受光素子に入射する光の波長を選択する波長選択層と、を有する固体撮像装置であって、該波長選択層がフォトニック結晶から成ることを特徴とするので、斜め光が入射した場合にでも、入射光の内で所定の波長領域の光がフォトニック結晶に沿って垂直に受光素子に導かれるため、隣接の画素のカラーフィルターに入射することがなく、混色を大幅に防止することができる。

[0011]

また、上記に記載の固体撮像装置を備えたカメラ、としてもよい。この特徴を備えたカメラを使って混色の極めて少ない、高画質の撮像が得られる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0012]

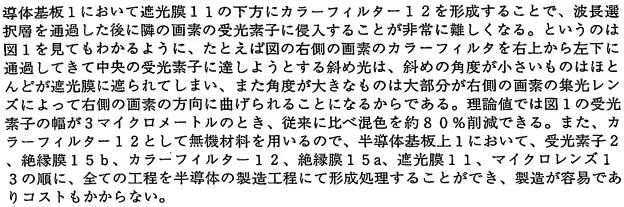
本発明の実施の形態に係る固体撮像装置について図面をもとに説明する。なお図5、図6と同一のものは同一の符号を付している。

(実施の形態1)

実施の形態1としての固体撮像装置における画素部断面図を図1に示す。同図は3つの隣り合う画素の断面を示しており、シリコン半導体基板1の中にフォトダイオードからなる受光素子2が形成されている。受光素子2の上には、光透過性の絶縁膜の層15bを形成し、その上に通過させるべき波長を選択する波長選択層12があり、さらにその上に同じく光透過性の絶縁膜15aを形成する。波長を選択するとは、光の特定の幅の波長だけを通すか、または通さないことである。実施の形態1では波長選択層として原色の光を通すカラーフィルター12を無機材料によって形成する。カラーフィルタ12の色の配列は、ベイア配列あるいは補色配列を採用する。たとえばベイア配列の場合、波長選択層12により、R,G,Bの原色のいずれかの波長域の色だけが選択される。絶縁膜の層15aの上には入射する光14を遮るアルミ材の遮光膜11が形成されている。遮光膜11は入射した光14を遮光するが、画素ごとに各受光素子2の上だけ開口した開口部19があり、画素に入射した光14はその画素の開口部19を通って受光素子2に到達できるようになっている。最後に画素ごとに遮光膜11の開口部19上にマイクロレンズ13を形成する。なお遮光膜11とその開口部19により遮光層が形成される。

[0013]

入射する光は、遮光膜11に達したときは反射し、それ以外は画素のマイクロレンズ13によって集められて当該画素の中心方向に向けられ、カラーフィルタ12により選択された波長の光17だけとなり、当該画素の受光素子2に入る。実施の形態1において、半



[0014]

(実施の形態2)

次に実施の形態2としての固体撮像装置における画素部断面を図2に示す。実施の形態1と異なるところは、この実施の形態では、受光素子2と遮光膜11の間に光の波長選択層として多層膜16を用いていることであり、この多層膜16の形成条件を各受光素子2上で異なるように形成して、選択された波長の光17を受光素子2に集める。多層膜16として、SiO2(シリコン酸化)膜とSi3N4(シリコン窒化)膜を交互に形成する。

[0015]

多層膜16は薄膜化が実現できるため、受光素子2と遮光膜11の距離を小さくすることができ、これにより混色を効果的に防ぐことができる。また受光素子2と遮光膜11の距離が小さくてすむために、マイクロレンズ13の集光率をあげる目的で集光角度を大きくした場合にでも隣の画素に光が入り難く、また集光率の向上による高感度化も同時に実現することができる。

[0016]

(実施の形態3)

実施の形態3としての固体撮像装置における画素部断面図を図3に示す。実施の形態1と異なるところは、この実施の形態では、受光素子2に入射する光の波長選択層としてフォトニック結晶16を用いていることである。この構成によれば、斜め光が入射した場合にでも、フォトニック結晶18に沿って選択された波長の光17が垂直に受光素子2に導かれるため、隣接の画素の受光素子に入射することがなく、混色防止の効果を大きくすることができる。

[0017]

(実施の形態4)

実施の形態4としての固体撮像装置における画素部断面図を図4に示す。この形態では 光の波長選択層として実施の形態3と同じくフォトニック結晶16を用いている。実施の 形態3と異なるところは、この実施の形態では、遮光膜11を従来と同様に受光素子2と 波長選択層であるフォトニック結晶16の層の間に形成していることである。この形態で は、斜め光が入射した場合にでもフォトニック結晶16に沿って選択された波長の光17 が垂直に受光素子2に導かれるため、隣接の画素の受光素子に入射することがなく、混色 を防止することができる。なおフォトニック結晶16は誘電率あるいは屈折率の異なる物 質、たとえば半導体と空気を光の波長の長さで周期配列させた微細構造物である。特定の バンド幅の波長の光を通さない(フォトニックバンドギャップ)フォトニック結晶の例と して、科学技術振興事業団報 第323号の「面内へテロ・フォトニック結晶による光ナ ノデバイスの実現」で開示されたものがある。

【産業上の利用可能性】

[0018]

ディジタルカメラの撮像の手段としてあるいはエリアセンサとして利用できる。

【図面の簡単な説明】

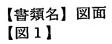
[0019]

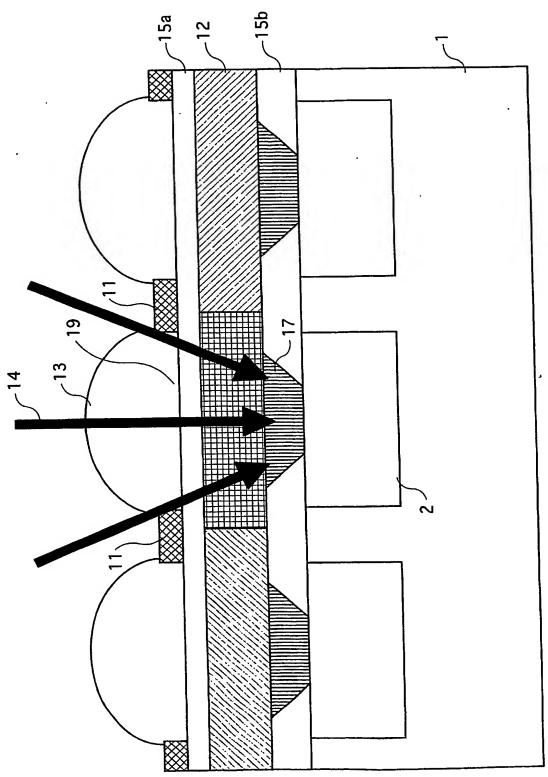
- 【図1】本発明に係る実施の形態1における画素部断面図である。
- 【図2】実施の形態2における画素部断面図である。
- 【図3】実施の形態3における画素部断面図である。
- 【図4】実施の形態4における画素部断面図である。
- 【図5】従来技術の固体撮像装置平面図である。
- 【図6】従来技術の画素部断面図である。

【符号の説明】

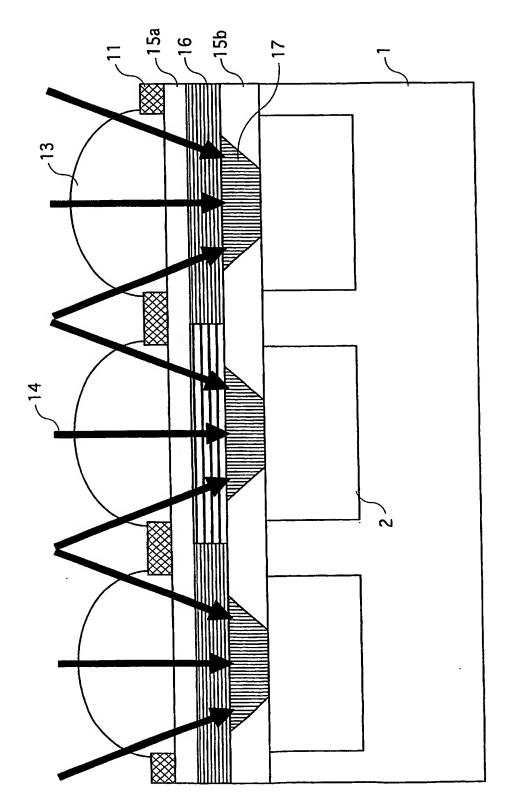
[0020]

- 1 半導体基板
- 2 受光素子
- 11 遮光膜
- 12 カラーフィルター
- 13 マイクロレンズ
- 14 入射光
- 15a,15b 絶縁膜
- 16 多層膜
- 17 選択された波長の光
- 18 フォトニック結晶
- 19 遮光層開口部

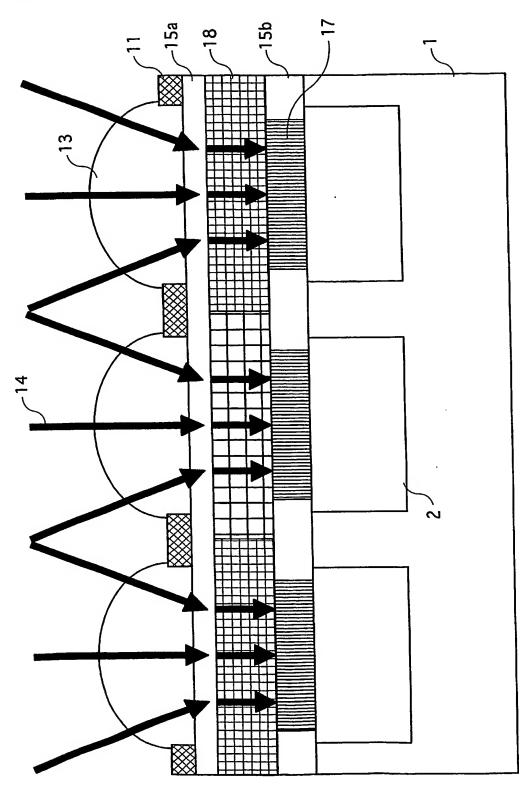




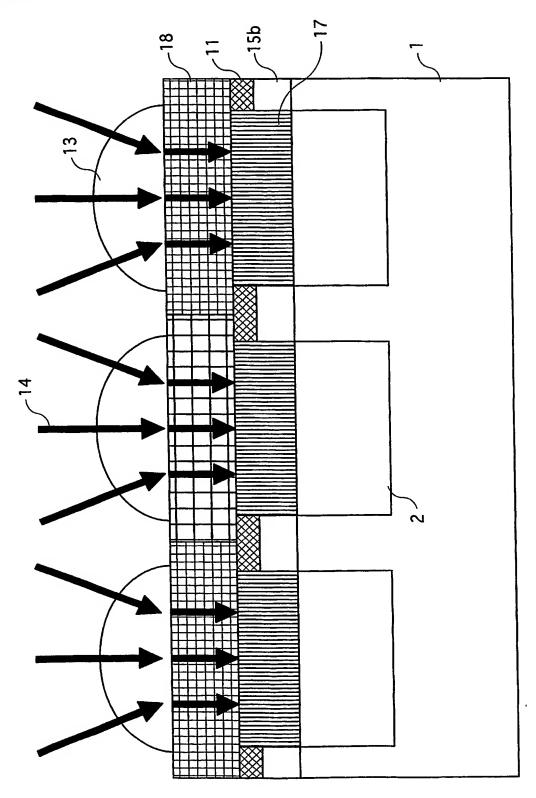




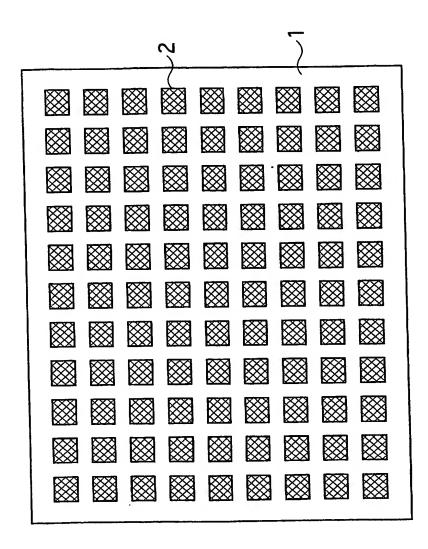




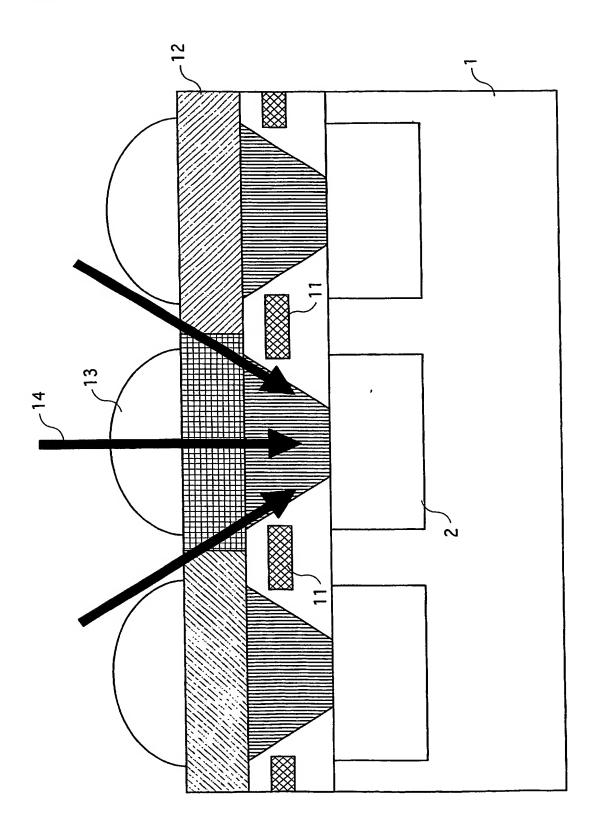


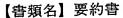












【課題】

半導体基板からなる画素断面においてカラーフィルターが遮光膜の上に形成した従来の 構造では、斜め光が隣の画素のカラーフィルターの一部を通過した後に受光素子に入射す る場合があり、隣の画素の色との混色が発生してしまう。本発明の課題はこの混色をでき るだけ防止することにある。

【解決手段】

半導体基板において遮光膜の下方にカラーフィルターを形成する。これにより斜め光が カラーフィルターを通過した後に隣の画素の受光素子に侵入することが非常に難しくなる 。たとえば図1の右側の画素のカラーフィルタを右上から左下に通過してきて中央の受光 素子に達しようとする斜め光は、斜めの角度が小さいものはほとんどが遮光膜に遮られる 。本発明により従来に比べ混色を大幅に防止できる。

【選択図】図1

特願2003-285254

出願人履歴情報

識別番号

[000005821]

1. 変更年月日

1990年 8月28日

[変更理由] 住 所

新規登録 大阪府門真市大字門真100_.6番地

氏 名

松下電器産業株式会社

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
П отикр.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.